```
2/7/1
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.
009060264
             **Image available**
WPI Acc No: 1992-187653/*199223*
 Forming photosensitive resin compsn. pattern - by forming film of
 polyamide acid ester, irradiating light through mask and developing with
 aq. alkali
Patent Assignee: SUMITOMO BAKELITE CO (SUMB )
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001
Patent Family:
Patent No
               Kind
                      Date
                               Applicat No
                                                Kind Date
JP 4116557
               A 19920417 JP 90235783
                                                A 19900907 199223 B
Priority Applications (No Type Date): JP 90235783 A 19900907
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                         Main IPC
                                        Filing Notes
JP 4116557
                     6 G03F-007/027
              Α
Abstract (Basic): JP 4116557 A
        A film is based on polyamide acid ester of formula (I). In (I) R1 =
    a 3 or 4-valent organic gp.; R2 = a 2 valent-organic gp.; R3 =
    -R4-O-C(O)-C(R5)=CH2)p where R4=a 3 - 6-valent organic gp.; R5=H or a CH3 gp.; 1, m and n = 0 - 1; p = 2 - 5; x = at least 1; y = at least
    100; z = 0 - 90; x + y + z = 100; x, y and z = in percent. Light is irradiated through a mask at the film. The film is developed in an aq.
    alkali soln. to form the relief pattern.
         USE/ADVANTAGE - The method forms photosensitive resin compsn.
    pattern. The film is dissolved in the aq. alkali soln. having less
    environmental pollution without decreasing sensitivity. The result
    safetly and easily forms the high-definition relief pattern with high
    sensitivity.
Derwent Class: A23; A89; G06; P81; P84; U11
International Patent Class (Main): G03F-007/027
International Patent Class (Additional): G02F-001/1337; G03F-007/038;
```

H01L-021/027

⑨ 日本国特許庁(JP) ⑪ 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-116557

®Int. Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	❸公開	平成 4年(1992) 4月17日
	7/027 7/038	5 1 4 5 0 4 5 0 5	9019—2H 7124—2H 7124—2H		
	1/027 1/1337	5 2 0	8806-2K 7352-4M H 01 I	_ 21/30	301 R
				,	301 K 請求項の数 1 (全6頁)

69発明の名称 感光性樹脂組成物のパターン形成方法

> 頭 平2-235783 20特

> > 孝.

22出 顧 平2(1990)9月7日

@発 明 者 指 田 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ペークライト

株式会补内

東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト

株式会社内

@発 明 者 光 弘 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト

株式会社内

住友ペークライト株式 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 勿出 願 人

会社

1. 発明の名称

70発 明

感光性樹脂組成物のパターン形成方法

2. 特許請求の範囲

(1)下記式(Ⅰ)で示されるポリアミド酸エステ ル

(式中、Ri:3又は4価の有機基、Ra:2価の有機基、

あって、同じであっても違っていてもよい。

1,m,n:0 又は 1、 p:2~5の整数、

1 < x, y < 100, 0 < z < 90 $\Rightarrow x + y + z = 100$ x,y,Z:各構造単位の百分率)

を主成分とする皮膜にマスクを介し光を照射し、 これをアルカリ水溶液にて現像してレリーフパタ ーンを形成するパターン形成方法。

3. 発明の詳細な説明

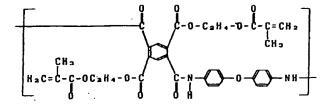
[産業上の利用分野]

本発明は、高感度で、かつ公害問題が生じ難い、 アルカリ水溶液にて現像できる感光性樹脂組成物 のパターン形成方法に関するものである。

[従来の技術]

従来、半導体素子の表面保護膜、層間絶縁膜な どには、耐熱性が優れ、また卓越した電気絶縁性、 機械強度などを有するポリイミドが用いられてい るが、ポリイミドパターンを作成する繁雑な工程 を簡略化する為にポリイミド自身に感光性を付与 する技術が最近注目を集めている。

例えば、下式



で示されるような精道のエステル基で感光性基を 付与したポリイミド前駆体組成物(例えば特公昭 55-41422号公報)、あるいは下式

$$(R_0: \bigcirc R_{10}: -\bigcirc -\bigcirc -\bigcirc -)$$

で示されるような構造のポリアミック酸に化学線 により2量化、または重合可能な炭素-炭素二重

カリ水溶液による現像を可能にするパターン形成 方法を提供するにある。

[課題を解決するための手段]

本発明は、下記式 (I) で示されるポリアミド 酸エステル

(式中、R1:3又は4個の有機基、R2:2個の有機基、

R *: 3~6価の有機基、R s: H 又は CH s 基 それぞれのR 1, R 2, R 3, R 4, R s はそれぞれが独立で あって、同じであっても違っていてもよい。

1.m.n:0 又は 1、 p:2~5の整数、

1 < x, y < 100, 0 < z < 90 $\Rightarrow x + y + z = 100$

結合およびアミノ基または、その四級化塩を含む 化合物を添加した組成物(例えば特開昭54-145794 号公報)などが知られている。

これらは、いずれも適当な有機溶剤に溶解し、 ワニス状態で塗布、乾燥した後、フォトマスクを 介して紫外線照射し、有機溶剤にて現像、リンス 処理して所望のパターンを得、さらに加熱処理す ることによりポリイミド被膜としている。

しかし、かかる従来の感光化技術において、アルカリ水溶液で現像しようとした場合、エステル基に感光基を導入した方法では全く現像することができない。またイオン結合的に感光基を導入した方法では、露光部と未露光部に溶解性の差がでず、全て溶出してしまい、アルカリ水溶液での現像は不可能であった。

[発明が解決しようとする課題]

本発明の目的とするところは、ポリアミド酸中の一部のカルボキシル基へ多官能のアクリル(メタクリル)基を導入した樹脂組成物を用いることにより、高感度でかつ公客問題を生じ難い、アル

х,у,2:各構造単位の百分率)

を主成分とする皮膜にマスクを介し光を照射し、 これをアルカリ水溶液にて現像してレリーフパタ ーンを形成するパターン形成方法である。

[作用]

本発明において用いる一般式(I)で示されるポリアミド酸エステルは、高い感度を有しながら、残存するカルボキシル成分により、現像時のフィルム強度に優れる性能を向上させ、かつ砂に、アルカリ水溶液に溶解可能となり、アルカリ水溶液に溶解可能となり、アルカリ水溶液に溶解可能となり、その表表を自動を表現して、一般では、1)中、R1は3又は4価の有機基を有する化合物からなもので、過常をある。例えば、トリメリットをないが主に使用される。例えば、トリメリット酸無水物、ピロメリット酸二無水物、3,3′,4,4′-ベンプフェノンテトラカルボン酸二無水物、2,2′,3,3′-ベンプフェノンテトラカルボン酸二無水物、2,2′,3,3′-ベンプフェノンテトラカルボン酸ニ無水物、2,2′,3,3,3′-ベンプフェノンテトラカルボン酸ニ無水物、2,3、

3'.4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、 ナフタレン-2,3,6,7-テトラカルボン酸二無水物、 ナフタレン-1,2,5,6-テトラカルボン酸二無水物、 ナフタレン-1,2,4,5-テトラカルボン酸二無水物、 ナフタレン-1,4,5,8-テトラカルポン酸二無水物、 ナフタレン-1,2,6,7-テトラカルポン酸二無水物、 4,8-ジメチル-1,2,3,5,6,7-ヘキサヒドロナフタ レン-1,2,5,6-テトラカルボン酸二無水物、4,8-ジメチル-1,2,3,5,6,7-ヘキサヒドロナフタレン-2,3,6,7-テトラカルポン酸二無水物、2,6-ジクロ ロナフタレン-1,4,5,8-テトラカルポン酸二無水 物、2.7-ジクロロナフタレン-1.4.5.8-テトラカ ルボン酸二無水物、2.3.6.7-テトラクロロナフタ レン-1,4,5,8-テトラカルボン酸二無水物、1,4,5. 8-テトラクロロナフタレン-2,3,6,7-テトラカル ボン酸二無水物、3,3',4,4'~ジフェニルテトラカ ルポン酸二無水物、2,2',3,3'-ジフェニルテトラ カルボン酸二無水物、2,3,3',4'-ジフェニルテト ラカルボン酸二無水物、3,3'',4,4''-p-テルフェ ニルテトラカルボン酸二無水物、2,2'',3,3''-p-

テルフェニルテトラカルポン酸二無水物、2,3,3' ',4''-p-テルフェニルテトラカルポン酸二無水物、 2,2-ビス(2,3-ジカルポキシフェニル)-プロパン 二無水物、2,2-ピス(3,4-ジカルポキシフェニル)-プロパン二無水物、ピス(2,3-ジカルボキシフェ ニル)エーテル二無水物、ピス(3,4-ジカルポキシ フェニル)エーテル二無水物、ビス(2,3-ジカルボ キシフェニル)メタン二無水物、ピス(3,4-ジカル ボキシフェニル)メタン二無水物、ビス(2,3-ジカ ルポキシフェニル)スルホン二無水物、ビス(3,4-ジカルポキシフェニル)スルホン二無水物、1.1-ピス(2,3-ジカルボキシフェニル)エタン二無水物、 1.1-ピス(3.4-ジカルポキシフェニル)エタン二無 水物、ペリレン-2.3.8.9-テトラカルボン酸二無 水物、ペリレン-3.4,9,10-テトラカルボン酸二無 水物、ペリレン-4,5,10,11-テトラカルボン酸二 無水物、ペリレン-5.6,11,12-テトラカルポン酸 二無水物、フェナンスレン-1,2,7,8-テトラカル ポン醇二無水物、フェナンスレン-1,2,6,7-テト ラカルポン酸二無水物、フェナンスレン-1,2,9,

10-テトラカルボン酸二無水物、シクロベンタン-1, 2,3,4-テトラカルボン酸二無水物、ピラジン-2,3, 5,6-テトラカルボン酸二無水物、ピロリジン-2,3, 4,5-テトラカルボン酸二無水物などがあげられるが、これらに限定されるものではない。また、使用にあたっては、1種類でも2種類以上の混合物でもかまわない。

本発明において用いる Raは、 2 価の有機基で、通常芳香族ジアミン及び/又はその誘導体が使用される。例えば m-フェニレン-ジアミン、1-イソプロピル-2,4-フェニレン-ジアミン、p-フェニレン-ジアミン、4,4'-ジアミノ-ジフェニルプロパン、3,3'-ジアミノ-ジフェニルエタン、3,3'-ジアミノ-ジフェニルメタン、3,3'-ジアミノ-ジフェニルメタン、1,4'-ジアミノ-ジフェニルスルフィド、3,3'-ジアミノ-ジフェニルスルフィド、1,4'-ジアミノ-ジフェニルスルフィド、1,4'-ジアミノ-ジフェニルスルホン、3,3'-ジアミノ-ジフェニルスルホン、

4.4'-ジアミノ-ジフェニルエーテル、J.3'-ジア ミノ-ジフェニルエーテル、ベンジジン、3,3′-ジ アミノ-ピフェニル、3,3′-ジメチル-4,4′-ジアミ ノ-ビフェニル、3,3'-ジメトキシ-ベンジジン、4, 4''-ジアミノ-p-テルフェニル、3,3''-ジアミノp-テルフェニル、ピス(p-アミノ-シクロヘキシル) メタン、ビス(p-β-アミノ-t-プチルフェニル)エ ーテル、ビス(p-β-メチル-δ-アミノベンチル) ペンゼン、p-ピス(2-メチル-4-アミノ-ペンチル) ペンゼン、p-ピス(1,1-ジメチル-5-アミノ-ペン チル)ペンゼン、1,5-ジアミノ-ナフタレン、2.6-ジアミノ-ナフタレン、2.4-ビス(β-アミノ-t-ブ チル)トルエン、2,4-ジアミノ-トルエン、中キシ レン-2,5-ジアミン、p-キシレン-2,5-ジアミン、 ■-キシリレン-ジアミン、p-キシリレン-ジアミン、 2.6-ジアミノ-ビリジン、2.5-ジアミノ-ビリジン、 2.5-ジアミノ-1.3.4-オキサジアゾール、1.4-ジ アミノ-シクロヘキサン、ピペラジン、メチレン-ジアミン、エチレン-ジアミン、プロピレン-ジア ミン、2,2-ジメチル-プロピレン-ジアミン、テト

ラメチレン-ジアミン、ペンタメチレン-ジアミン、 ヘキサメチレン-ジアミン、2,5-ジメチル-ヘキサ メチレン-ジアミン、3-メトキシ-ヘキサメチレン ジアミン、ヘブタメチレン-ジアミン、2,5-ジメ チル-ヘブタメチレン-ジアミン、3-メチル-ヘブ タメチレン-ジアミン、4.4-ジメチル-ヘブタメチ レン-ジアミン、オクタメチレン-ジアミン、ノナ メチレン-ジアミン、5-メチル-ノナメチレン-ジ アミン、2,5-ジメチル-ノナメチレン-ジアミン、 **デカメチレン-ジアミン、1,10-ジアミノ-1,10-ジ** メチル-デカン、2,11-ジアミノ-ドデカン、1,12-ジアミノ-オクタデカン、2,12-ジアミノ-オクタ デカン、2,17-ジアミノ-アイコサン、ジアミノシ ロキサン、2,6-ジアミノ-4-カルポキシリックベ ンゼン、3,3'-ジアミノ-4,4'-ジカルポキシリッ クペンジジンなどがあげられるが、これらに限定 されるものではない。また使用にあたっては、1 種類でも2種類以上の混合物でもかまわない。

本発明に使用する一般式(I)中、Raは、アクリル (メタクリル) 基を2~5基有する多官能な感

リスリトールトリアクリレート、トリメチロール プロパンジメタクリレート及びこれらの誘導体が あげられるが、これらに限定されない。これらの 使用にあたっては1種類でも2種類以上の混合物 でもかまわない。

本発明におけるポリアミド酸エステル(1)は、 通常以下のようにして合成される。まず、アルコ 光性基である。アクリル(メタクリル)基が1基 では架橋密度が低く低感度のものしか得られず好 ましくない。また6基以上のアクリル(メタクリ ル)基は工業上製造が困難であるばかりでなく、 分子量が大きくなるため相溶性が低下し好ましく ない。Roを導入するための化合物としては、例え ば、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペ ンタエリスリトールトリメタクリレート、ペンタ エリスリトールアクリレートジメタクリレート、 ペンタエリスリトールジアクリレートメタクリレ ート、ジベンタエリスリトールベンタアクリレー ト、ジベンタエリスリトールベンタメタクリレー ト、グリセロールジアクリレート、グリセロール ジメタクリレート、グリセロールアクリレートメ タクリレート、トリメチロールプロパンジアクリ レート、1,3-ジアクリロイルエチル-5-ヒドロキ シエチルイソシアヌレート、1.3-ジメタクリレ-ト-5-ヒドロキシエチルイソシアヌレート、エチ レングリコール変性ペンタエリスリトールトリア クリレート、プロピレングリコール変性ペンタエ

ール基を有する多官能感光基R3を溶媒に溶解させ、これに過剰の酸無水物又はその誘導体を反応させる。この後、残存するカルボキシル基、酸無水物基に、ジアミンを反応させることにより合成することができる。即ち、R3成分、酸無水物成分、ジアミン成分の反応モル比を制御することにより、カルボキシル基の感光基置換率を容易に制御することが可能である。

上記のポリアミド酸エステル(I)以外にも感光特性やその他の特性を向上させるために、各種光開始剤、増感剤、感光助剤、アクリル(メタクリル)オリゴマー、禁止剤、着色剤、光散乱防止剤、分散剤、充填剤、接着助剤、皮膜平滑剤、溶剤等を添加しても細わない。

本発明による感光性樹脂組成物の皮膜作成方法は、まず、該組成物を適当な支持体、例えばシリコンウェハーやセラミック、アルミ基板などに塗布する。塗布方法は、スピンナーを用いた回転塗布、スプレーコーターを用いた噴霧塗布、浸漬、

印刷、ロールコーティングなどで行なう。次に、60~80℃の低温でプリベークして塗膜を乾燥することによって得られる。次に、この皮膜に対し、所望のパターン形状に化学線を照射する。化学線としては、X線、電子線、紫外線、可視光線などが使用できるが、200~500nmの波長のものが好ましい。さらにこの化学線を照射した皮膜に対し、アルカリ水溶液で現像することによりレリーフパターンを得る。

アルカリ水溶液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、n-プロピルアミン等の第二アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、トリエチルアミンメチルエタノールアミン、トリエタノールアミンメチルエタノールアミンは、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド等の第四級アンモニウム塩等アルカリ

ステル化した後、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル 170.2g(0.85モル)をジシクロヘキシルカルボジイミドを縮合剤として、ポリアミド酸エステル共重合物を得た。ジシクロヘキシルウレアを適別後、エタノールに再沈し、固形物を濾過し、減圧乾燥した。次に、このポリアミド酸エステル100重量部に、ミヒラーケトン(入 max 365nm)5 重量部及びメチルエーテルハイドロキノン0.1重量部をN,N-ジメチルアクリルアミド300重量部に溶解させ、感光性樹脂組成物を得た。

得られた溶液をアルミ板上にスピンナーで塗布 し、乾燥機により60℃で1時間乾燥した。

このフィルムにコダック社製フォトグラフィックステップタブレットNo2, 21ステップ(本グレースケールでは、段数が一段増加するごとに透過光量が前段の1 / √ 2 に減少するので現像後の残存段階が大きいものほど感度が良い)を重ね、500æJ/cæ²の紫外線を照射し、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド 1 %水溶液にて、1 分間ディップ現像し、さらに純水でリンスをしたところ、

類の水溶液、及びこれにメタノール、エタノールのようなアルコール等の水溶性有機溶媒や界面活性剤を適当量添加した水溶液を好適に使用することができる。

現像方法としては、例えばスプレー、パドル、 漫漕、超音波などの方式が可能である。

次に、現像によって形成したレリーフパターンをリンスする。リンス液としては、例えば蒸留水を使用する。次に加熱処理を行ない、耐熱性に富む最終パターンを得る。

本発明による感光性樹脂組成物は、半導体用途 のみならず、多層回路の層間絶縁膜やフレキシブ ル銅張板のカバーコート、ソルダーレジスト膜や 液晶配向膜などとしても有用である。

以下実施例により本発明を具体的に説明する。 (実施例1)

ピロメリット酸二無水物 65.5g(0.30モル)と3, 3',4,4'-ペンプフェノンテトラカルボン酸二無水 物 225.5g(0.70モル)とを、2-ヒドロキシ-1,3-ジメタクリロキシプロパン 228g(1.00モル)でエ

14段までパターンが残存し、高感度であることが 判った。また別途解像度評価用マスク(凸版印刷 瞬製)を用いて200mJ/cm²照射し、同様に現像を 行った結果、4μmまで解像し、鲜明なレリーフパ ターンが得られることが判った。

(実施例2)

実施例1中、2-ヒドロキシ-1,3-ジメタクリロキシプロバンをベンタエリスリトールトリアクリレートに替えて樹脂組成物を得、実施例1と同様の評価を行った。その結果、ステップタブレット段数は16段と高感度にアルカリ水溶液現像することができた。さらに解像度は4μ■と鮮明なレリーフバターンが得られた。

(実施例3)

実施例 1 中、N.N-ジメチルアクリルアミドをトメチル-2-ピロリドンに替えて樹脂組成物を得、実施例 1 と同様の評価を行った。ステップタプレット段数は11段と高感度で、また解像度も5 μ m と 鮮明なレリーフパターンがアルカリ水溶液現像にて得られた。

(比較例1)

実施例1中、2-ヒドロキシ-1,3-ジメタクリロキシプロバンの反応量を 547.2g(2.4モル)として反応させ、その後同様の操作を行い、樹脂組成物を得、さらに同一の評価を行った。しかし10分後でも現像できず、実用性のないことが判った。 (比較例2)

実施例1中、2-ヒドロキシ-1,3-ジメタクリロキシプロパンを2-ヒドロキシエチルメタクリレートに替え、反応させ、機能組成物を得、さらに同様の評価を行った。感度は6段と低く、また解像度を評価しようとしたがレリーフパターンが崩れ正確な評価ができず、実用性のないことが判った。 【発明の効果】

従来、ポリアミド酸のカルボキシル基にエステル状に感光性基を導入する技術が知られていたが、かかる従来技術ではアルカリ現像することが不可能であった。しかし本発明では、ポリアミド酸の一部に多官能の感光基を導入することにより感度を低下させることなく、公客問題の生じ難いアル

カリ水溶液に良く溶解させることが可能となった。 このためアルカリ水溶液で現像することにより、 高感度で、かつ高解像度のレリーフパターンを安 全にかつ容易に得られる方法を見出すことができ た。

特許出願人 住友ペークライト株式会社